



(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2011-0011079  
(43) 공개일자 2011년02월08일

(51) Int. Cl.

*H01L 51/54* (2006.01) *H05B 33/18* (2006.01)

(21) 출원번호 10-2009-0068544

(22) 출원일자 2009년07월27일

심사청구일자 없음

(71) 출원인

엘지디스플레이 주식회사

서울 용산구 한강로3가 65-228

(72) 발명자

허정행

경북 구미시 황상동 201번지

김관수

경북 구미시 형곡동 145-22 신세계타운 1305호

정승룡

경북 구미시 봉곡동 224번지 LGD인재관 215호

(74) 대리인

특허법인로얄

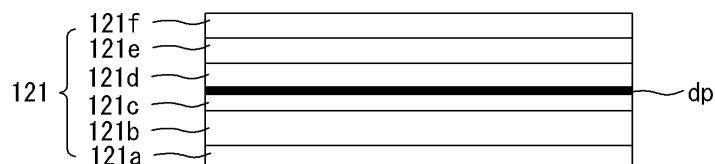
전체 청구항 수 : 총 8 항

(54) 유기전계발광표시장치

### (57) 요 약

본 발명은, 기판; 기판 상에 위치하는 하부전극; 하부전극 상에 위치하는 유기 발광층; 및 유기 발광층 상에 위치하는 상부전극을 포함하며, 유기 발광층은, 발광층에 포함된 도편트와 동일한 도편트가 포함된 정공수송층을 포함하는 유기전계발광표시장치를 제공한다.

대 표 도 - 도6



## 특허청구의 범위

### 청구항 1

기판;

상기 기판 상에 위치하는 하부전극;

상기 하부전극 상에 위치하는 유기 발광층; 및

상기 유기 발광층 상에 위치하는 상부전극을 포함하며,

상기 유기 발광층은,

발광층에 포함된 도편트와 동일한 도편트가 포함된 정공수송층을 포함하는 유기전계발광표시장치.

### 청구항 2

제1항에 있어서,

상기 정공수송층은,

정공주입층에 인접하는 제1정공수송층과, 상기 발광층에 인접하는 제2정공수송층을 포함하며,

상기 도편트가 포함된 정공수송층은 상기 제2정공수송층인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

### 청구항 3

제2항에 있어서,

상기 제2정공수송층의 두께는,

상기 제1정공수송층의 두께보다 얇은 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

### 청구항 4

제2항에 있어서,

상기 제2정공수송층은,

상기 도편트를 제외하고 상기 제1정공수송층과 동일한 재료를 포함하는 유기전계발광표시장치.

### 청구항 5

제1항에 있어서,

상기 도편트는 형광 도편트인 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

### 청구항 6

제1항에 있어서,

상기 유기 발광층은,

상기 하부전극 상에 위치하는 정공주입층과,

상기 정공주입층 상에 위치하는 제1정공수송층과,

상기 제1정공수송층 상에 위치하며 상기 도편트가 포함된 제2정공수송층과,

상기 제2정공수송층 상에 위치하는 상기 발광층과,

상기 발광층 상에 위치하는 전자수송층과,

상기 전자수송층 상에 위치하는 전자주입층을 포함하는 유기전계발광표시장치.

### 청구항 7

제6항에 있어서,

상기 정공주입층과 상기 제2정공수송층의 두께는 동일한 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

### 청구항 8

제6항에 있어서,

상기 제1정공수송층의 두께는,

상기 전자수송층의 두께보다 두꺼운 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

## 명세서

### 발명의 상세한 설명

#### 기술분야

[0001]

본 발명은 유기전계발광표시장치에 관한 것이다.

#### 배경기술

[0002]

유기전계발광표시장치에 사용되는 유기전계발광소자는 두 개의 전극 사이에 발광층이 형성된 자발광소자이다. 유기전계발광소자는 전자(election) 주입전극(cathode)과 정공(hole) 주입전극(anode)으로부터 각각 전자와 정공을 발광층 내부로 주입시켜, 주입된 전자와 정공이 결합한 엑시톤(exciton)이 여기 상태로부터 기저상태로 떨어질 때 발광하는 소자이다.

[0003]

유기전계발광소자를 이용한 유기전계발광표시장치는 빛이 방출되는 방향에 따라 상부발광(Top-Emission) 방식, 하부발광(Bottom-Emission) 방식 및 양면발광(Dual-Emission) 등이 있고, 구동방식에 따라 수동매트릭스형(Passive Matrix)과 능동매트릭스형(Active Matrix) 등으로 나누어진다.

[0004]

유기전계발광표시장치는 매트릭스 형태로 배치된 복수의 서브 픽셀에 스캔 신호, 데이터 신호 및 전원 등이 공급되면, 선택된 서브 픽셀이 발광을 하게 됨으로써 영상을 표시할 수 있다.

[0005]

서브 픽셀은 스위칭 트랜지스터, 구동 트랜지스터 및 커패시터를 포함하는 트랜지스터부와 트랜지스터부에 포함된 구동 트랜지스터에 연결된 하부전극, 유기 발광층 및 상부전극을 포함하는 유기 발광다이오드를 포함한다. 유기 발광층은 전자와 정공의 주입과 이동을 돋는 공통층과 발광층을 포함한다. 종래 유기 발광층의 구조는 발광층에만 도편트(dopant)를 형성하여 발광하도록 하였다. 그런데, 종래 구조의 경우 발광층에서 여기에 참여하지 못한 전자들이 공통층 중 하부전극과 인접한 정공수송층을 통하여 흐르는 문제가 있어 소자의 발광 효율을 저하하고 수명을 낮추는 문제를 야기하므로 이의 개선이 요구된다.

#### 발명의 내용

#### 해결하고자하는 과제

[0006]

상술한 배경기술의 문제점을 해결하기 위한 본 발명은, 발광층에서 여기에 참여하지 못한 전자들을 돋고 발광층의 차지를 분산시켜 소자의 발광 효율을 개선함과 아울러 소자의 수명을 향상시킬 수 있는 유기전계발광표시장치를 제공하는 것이다.

#### 과제 해결수단

[0007]

상술한 과제 해결 수단으로 본 발명은, 기판; 기판 상에 위치하는 하부전극; 하부전극 상에 위치하는 유기 발광층; 및 유기 발광층 상에 위치하는 상부전극을 포함하며, 유기 발광층은, 발광층에 포함된 도편트와 동일한 도편트가 포함된 정공수송층을 포함하는 유기전계발광표시장치를 제공한다.

- [0008] 정공수송층은, 정공주입층에 인접하는 제1정공수송층과, 발광층에 인접하는 제2정공수송층을 포함하며, 도편트가 포함된 정공수송층은 제2정공수송층일 수 있다.
- [0009] 제2정공수송층의 두께는, 제1정공수송층의 두께보다 얇을 수 있다.
- [0010] 제2정공수송층은, 도편트를 제외하고 제1정공수송층과 동일한 재료를 포함할 수 있다.
- [0011] 도편트는 형광 도편트일 수 있다.
- [0012] 유기 발광층은, 하부전극 상에 위치하는 정공주입층과, 정공주입층 상에 위치하는 제1정공수송층과, 제1정공수송층 상에 위치하는 도편트가 포함된 제2정공수송층과, 제2정공수송층 상에 위치하는 발광층과, 발광층 상에 위치하는 전자수송층과, 전자수송층 상에 위치하는 전자주입층을 포함할 수 있다.
- [0013] 정공주입층과 제2정공수송층의 두께는 동일할 수 있다.
- [0014] 제1정공수송층의 두께는, 전자수송층의 두께보다 두꺼울 수 있다.

### 효과

- [0015] 본 발명은, 발광층에서 여기에 참여하지 못한 전자들을 둡고 발광층의 차지를 분산시킬 수 있는 정공수송층을 마련하여 소자의 발광 효율을 개선함과 아울러 소자의 수명을 향상시킬 수 있는 유기전계발광표시장치를 제공하는 효과가 있다.

### 발명의 실시를 위한 구체적인 내용

- [0016] 이하, 본 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 첨부된 도면을 참조하여 설명한다.
- [0017] <제1실시예>
- [0018] 도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 개략적인 블록도이고, 도 2는 도 1에 도시된 서브 픽셀의 회로구성 예시도이다.
- [0019] 도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 제1실시예에 따른 유기전계발광표시장치는 매트릭스형태로 배치된 서브 픽셀(SP)을 포함하는 패널(PNL), 서브 픽셀(SP)의 스캔배선(SL1..SLm)에 스캔신호를 공급하는 스캔구동부(SDRV) 및 서브 픽셀(SP)의 데이터배선(DL1..DLn)에 데이터신호를 공급하는 데이터구동부(DDRV)를 포함한다.
- [0020] 서브 픽셀(SP)은 수동매트릭스형(Passive Matrix) 또는 능동매트릭스형(Active Matrix)으로 형성된다. 서브 픽셀(SP)이 능동매트릭스형으로 형성된 경우, 이는 스위칭 트랜지스터(S1), 구동 트랜지스터(T1), 커패시터(Cst) 및 유기 발광다이오드(D)를 포함하는 2T(Transistor)1C(Capacitor) 구조로 구성되거나 트랜지스터 및 커패시터가 더 추가된 구조로 구성될 수도 있다.
- [0021] 2T1C 구조의 경우, 서브 픽셀(SP)에 포함된 소자들은 다음과 같이 연결될 수 있다. 스위칭 트랜지스터(S1)는 스캔신호가 공급되는 스캔배선(SL1)에 게이트가 연결되고 데이터신호가 공급되는 데이터배선(DL1)에 일단이 연결되며 제1노드(A)에 타단이 연결된다. 구동 트랜지스터(T1)는 제1노드(A)에 게이트가 연결되고 제2노드(B)에 일단이 연결되며 저 전위의 전원이 공급되는 제2전원 배선(VSS)에 연결된 제3노드(C)에 타단이 연결된다. 커패시터(Cst)는 제1노드(A)에 일단이 연결되고 제3노드(C)에 타단이 연결된다. 유기 발광다이오드(D)는 고 전위의 전원이 공급되는 제1전원 배선(VDD)에 애노드가 연결되고 제2노드(B) 및 구동 트랜지스터(T1)의 일단에 캐소드가 연결된다.
- [0022] 위의 설명에서는 서브 픽셀(SP)에 포함된 트랜지스터들(S1, T1)이 N-Type으로 구성된 것을 일례로 설명하였으나 본 발명의 실시예는 이에 한정되지 않는다. 그리고 제1전원 배선(VDD)을 통해 공급되는 고 전위의 전원은 제2전원 배선(VSS)을 통해 공급되는 저 전위의 전원보다 높을 수 있으며, 제1전원 배선(VDD) 및 제2전원 배선(VSS)을 통해 공급되는 전원의 레벨은 구동방법에 따라 스위칭이 가능하다.
- [0023] 앞서 설명한 서브 픽셀(SP)은 다음과 같이 동작할 수 있다. 스캔배선(SL1)을 통해 스캔신호가 공급되면 스위칭 트랜지스터(S1)가 터온된다. 다음, 데이터배선(DL1)을 통해 공급된 데이터신호가 터온된 스위칭 트랜지스터(S1)를 거쳐 제1노드(A)에 공급되면 데이터신호는 커패시터(Cst)에 데이터전압으로 저장된다. 다음, 스캔신호가

차단되고 스위칭 트랜지스터(S1)가 턴오프되면 구동 트랜지스터(T1)는 커페시터(Cst)에 저장된 데이터전압에 대응하여 구동된다. 다음, 제1전원 배선(VDD)을 통해 공급된 고 전위의 전원이 제2전원 배선(VSS)을 통해 흐르게 되면 유기 발광다이오드(D)는 빛을 발광하게 된다. 그러나 이는 구동방법의 일례에 따른 것일 뿐, 본 발명의 실시예는 이에 한정되지 않는다.

[0024] 이하, 앞서 설명한 유기전계발광표시장치의 구조에 대해 설명한다.

[0025] 도 3은 유기전계발광표시장치의 평면도이고, 도 4는 도 3에 도시된 I-II 영역의 단면도이며, 도 5는 서브 픽셀의 단면도이고, 도 6은 본 발명의 제1실시예에 따른 유기 발광층의 구조도이다.

[0026] 도 3 및 도 4를 참조하면, 본 발명의 제1실시예에 따른 유기전계발광표시장치는 능동매트릭스형태로 형성된 서브 픽셀들에 의해 표시영역(AA)이 정의된 기판(110)과 기판(110) 상에 형성된 서브 픽셀들을 수분이나 산소로부터 보호하기 위한 밀봉기판(140)을 포함한다. 기판(110)과 밀봉기판(140)은 표시영역(AA)의 외곽에 위치하는 비표시영역(NA)에 형성된 접착부재(180)에 의해 합착 밀봉된다. 도시된 유기전계발광표시장치는 외부로부터 각종 신호나 전원을 공급받도록 기판(110)의 외곽에 패드부(170)가 마련되고, 하나의 칩으로 구성된 구동장치(160)에 의해 기판(110)과 밀봉기판(140)에 형성된 소자들이 구동되는 것을 일례로 한 것이다. 여기서, 구동장치(160)는 도 1에 설명된 데이터구동부와 스캔구동부 등을 포함한다. 이상 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광표시장치는 상부발광(Top-Emission) 방식, 하부발광(Bottom-Emission) 방식 및 양면발광(Dual-Emission) 중 어느 하나로 구현될 수 있다.

[0027] 이하, 도 5 및 도 6을 참조하여 서브 픽셀의 구조에 대해 설명하면 다음과 같을 수 있다.

[0028] 기판(110) 상에는 베퍼층(111)이 위치한다. 베퍼층(111)은 기판(110)에서 유출되는 알칼리 이온 등과 같은 불순물로부터 후속 공정에서 형성되는 박막 트랜지스터를 보호하기 위해 형성할 수 있다. 베퍼층(111)은 실리콘 산화물(SiO<sub>2</sub>), 실리콘 질화물(SiNx) 등을 사용할 수 있다.

[0029] 베퍼층(111) 상에는 게이트(112)가 위치한다. 게이트(112)는 몰리브덴(Mo), 알루미늄(Al), 크롬(Cr), 금(Au), 티타늄(Ti), 니켈(Ni), 네오디뮴(Nd) 및 구리(Cu)로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 또는 이들의 합금으로 이루어질 수 있다. 또한, 게이트(112)는 몰리브덴(Mo), 알루미늄(Al), 크롬(Cr), 금(Au), 티타늄(Ti), 니켈(Ni), 네오디뮴(Nd) 및 구리(Cu)로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 또는 이들의 합금으로 이루어진 다중층일 수 있다. 또한, 게이트(112)는 몰리브덴/알루미늄-네오디뮴 또는 몰리브덴/알루미늄의 2중층일 수 있다.

[0030] 게이트(112) 상에는 제1절연막(113)이 위치한다. 제1절연막(113)은 실리콘 산화막(SiO<sub>x</sub>), 실리콘 질화막(SiNx) 또는 이들의 다중층일 수 있으나 이에 한정되지 않는다.

[0031] 제1절연막(113) 상에는 액티브층(114)이 위치한다. 액티브층(114)은 비정질 실리콘 또는 이를 결정화한 다결정 실리콘을 포함할 수 있다. 여기서 도시하지는 않았지만, 액티브층(114)은 채널 영역, 소오스 영역 및 드레인 영역을 포함할 수 있으며, 소오스 영역 및 드레인 영역에는 P형 또는 N형 불순물이 도핑될 수 있다. 또한, 액티브층(114)은 접촉 저항을 낮추기 위한 오믹 콘택층을 포함할 수도 있다.

[0032] 액티브층(114) 상에는 소오스(115a) 및 드레인(115b)이 위치한다. 소오스(115a) 및 드레인(115b)은 단일층 또는 다중층으로 이루어질 수 있으며, 소오스(115a) 및 드레인(115b)이 단일층일 경우에는 몰리브덴(Mo), 알루미늄(Al), 크롬(Cr), 금(Au), 티타늄(Ti), 니켈(Ni), 네오디뮴(Nd) 및 구리(Cu)로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 또는 이들의 합금으로 이루어질 수 있다. 또한, 소오스(115a) 및 드레인(115b)이 다중층일 경우에는 몰리브덴/알루미늄-네오디뮴의 2중층, 몰리브덴/알루미늄/몰리브덴 또는 몰리브덴/알루미늄-네오디뮴/몰리브덴의 3중층으로 이루어질 수 있다.

[0033] 소오스(115a) 및 드레인(115b) 상에는 제2절연막(116)이 위치한다. 제2절연막(116)은 실리콘 산화막(SiO<sub>x</sub>), 실리콘 질화막(SiNx) 또는 이들의 다중층일 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 제2절연막(116)은 패시베이션막일 수 있다.

[0034] 제2절연막(116) 상에는 제3절연막(117)이 위치한다. 제3절연막(117)은 실리콘 산화막(SiO<sub>x</sub>), 실리콘 질화막(SiNx) 또는 이들의 다중층일 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 제3절연막(117)은 평탄화막일 수 있다.

[0035] 이상은 기판(110) 상에 위치하는 바탕 게이트형 구동 트랜지스터에 대한 설명이다. 이하에서는 구동 트랜지스터

상에 위치하는 유기 발광다이오드에 대해 설명한다.

[0036] 제3절연막(117) 상에는 하부전극(119)이 위치한다. 하부전극(119)은 애노드 또는 캐소드로 선택될 수 있다. 애노드로 선택된 하부전극(119)은 투명한 재료 예컨대, ITO(Indium Tin Oxide) 또는 IZO(Indium Zinc Oxide) 등을 사용할 수 있으나 이에 한정되지 않는다.

[0037] 하부전극(119) 상에는 하부전극(119)의 일부를 노출하는 개구부를 갖는 뱅크층(120)이 위치한다. 뱅크층(120)은 벤조사이클로부텐(benzocyclobutene, BCB)계 수지, 아크릴계 수지 또는 폴리이미드 수지 등의 유기물을 포함할 수 있으나 이에 한정되지 않는다.

[0038] 뱅크층(120)의 개구부 내에는 유기 발광층(121)이 위치한다. 도 6을 참조하면, 유기 발광층(121)은 정공주입층(121a), 제1정공수송층(121b), 제2정공수송층(121c), 발광층(121d), 전자수송층(121e) 및 전자주입층(121f)을 포함한다. 여기서, 제2정공수송층(121c)의 경우 발광층(121d)에 포함된 도편트와 동일한 도편트가 도팽층(dp)이 포함된다. 제2정공수송층(121c) 및 발광층(121d)에 포함된 도편트는 형광 도편트일 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 제1정공수송층(121b)과 제2정공수송층(121c)은 도편트를 제외하고 동일한 재료로 이루어질 수 있다. 한편, 유기 발광층(121) 내에 주입된 전자와 정공 중에서 정공의 이동도가 빠르다. 이를 참조하여 제1정공수송층(121b)을 형성할 때, 전자수송층(121e)의 두께보다 두껍게 형성하여 전자와 정공의 이동 밸런스를 조절한다.

[0039] 정공주입층(121a)은 정공의 주입을 원활하게 하는 역할을 할 수 있으며, CuPc(cupper phthalocyanine), PEDOT(poly(3,4)-ethylenedioxythiophene), PANI(polyaniline) 및 NPD(N,N-dinaphthyl-N,N'-diphenyl benzidine)로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상으로 이루어질 수 있으나 이에 한정되지 않는다.

[0040] 제1정공수송층(121b) 및 제2정공수송층(121c)은 정공의 수송을 원활하게 하는 역할을 하며, NPD(N,N-dinaphthyl-N,N'-diphenyl benzidine), TPD(N,N'-bis-(3-methylphenyl)-N,N'-bis-(phenyl)-benzidine), s-TAD 및 MTDATA(4,4',4"-Tris(N-3-methylphenyl-N-phenyl-amino)-triphenylamine)로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상으로 이루어질 수 있으나 이에 한정되지 않는다.

[0041] 발광층(121d)은 호스트와 도편트를 포함한다. 발광층(121d)은 적색, 녹색, 청색 및 백색을 발광하는 물질을 포함할 수 있으며, 인광 또는 형광물질을 이용하여 형성할 수 있다. 발광층(121d)이 적색을 발광하는 경우, CBP(carbazole biphenyl) 또는 mCP(1,3-bis(carbazol-9-yl)를 포함하는 호스트 물질을 포함하며, PIQIr(acac)(bis(1-phenylisoquinoline)acetylacetone iridium), PQIr(acac)(bis(1-phenylquinoline)acetylacetone iridium), PQIr(tris(1-phenylquinoline)iridium) 및 PtOEP(octaethylporphyrin platinum)로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상을 포함하는 도편트를 포함하는 인광물질로 이루어질 수 있고, 이와는 달리 PBD:Eu(DBM)3(Phen) 또는 Perylene을 포함하는 형광물질로 이루어질 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 발광층(121d)이 녹색을 발광하는 경우, CBP 또는 mCP를 포함하는 호스트 물질을 포함하며, Ir(ppy)3(fac tris(2-phenylpyridine)iridium)을 포함하는 도편트 물질을 포함하는 인광물질로 이루어질 수 있고, 이와는 달리, Alq3(tris(8-hydroxyquinolino)aluminum)을 포함하는 형광물질로 이루어질 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 발광층(121d)이 청색을 발광하는 경우, CBP, 또는 mCP를 포함하는 호스트 물질을 포함하며, (4,6-F2ppy)2Irpic를 포함하는 도편트 물질을 포함하는 인광물질로 이루어질 수 있다. 이와는 달리, spiro-DPVBi, spiro-6P, 디스틸벤젠(DSB), 디스트릴아릴렌(DSA), PFO계 고분자 및 PPV계 고분자로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 포함하는 형광물질로 이루어질 수 있으나 이에 한정되지 않는다.

[0042] 전자수송층(121e)은 전자의 수송을 원활하게 하는 역할을 하며, Alq3(tris(8-hydroxyquinolino)aluminum), PBD, TAZ, spiro-PBD, BA1q 및 SA1q로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나 이상으로 이루어질 수 있으나 이에 한정되지 않는다.

[0043] 전자주입층(121f)은 전자의 주입을 원활하게 하는 역할을 하며, Alq3(tris(8-hydroxyquinolino)aluminum), PBD, TAZ, LiF, spiro-PBD, BA1q 또는 SA1q를 사용할 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 본 발명의 실시예는 도 6에 한정되는 것은 아니며, 정공주입층(121a), 제1정공수송층(121b) 발광층(121d), 전자수송층(121e) 및 전자주입층(121f) 중 적어도 어느 하나가 생략될 수도 있다.

[0044] 유기 발광층(121) 상에는 제2전극(122)이 위치한다. 제2전극(122)은 캐소드 또는 애노드로 선택될 수 있다. 캐소드로 선택된 제2전극(122)은 알루미늄(Al) 등을 사용할 수 있으나 이에 한정되지 않는다.

- [0045] 이하, 본 발명의 제1실시예에 따른 유기 발광다이오드의 실험 예에 대해 설명한다.
- [0046] 도 7은 제1실시예에 따른 유기 발광다이오드의 계층도 이고, 도 8은 종래 구조와 실시예 간의 강도 대비 파장분포 그래프이며, 도 9는 종래 구조와 실시예 간의 강도 대비 발광시간 분포 그래프이다.
- [0047] 도 7을 참조하면, 본 발명의 제1실시예에 의해 구현된 유기 발광다이오드는 애노드로 선택된 하부전극(119)과 캐소드로 선택된 상부전극(122) 사이에 위치하는 정공주입층(121a), 제1정공수송층(121b), 도핑층(dp)을 포함하는 제2정공수송층(121c), 발광층(121d), 전자수송층(121e) 및 전자주입층(121f)을 포함한다.
- [0048] 실험 예에서, 제2정공수송층(121c)과 발광층(121d)에 사용된 도편트는 블루를 발광하는 형광 도편트를 일례로 한다. 이하, 하부전극(119)과 상부전극(122) 사이에 위치하는 각 층의 개략적인 조건을 설명하면 다음과 같다.
- [0049] [정공주입층(121a): 50Å, 제1정공수송층(121b): 650Å, 제2정공수송층(121c): 50Å + 도편트 6%, 발광층(121d): 호스트 300Å + 도편트 6%, 전자수송층(121e): 200Å, 전자주입층(121f): 10Å]
- [0050] 실험예에 따르면, 본 발명의 제1실시예에 따른 유기 발광다이오드는 발광층(121d)과 제2정공수송층(121c)에 동일한 도편트를 도핑함으로써, 제2정공수송층(121c)은 발광층(121d)에서 여기에 참여하지 못한 전자들이 하부전극(119) 방향으로 흐르지 않고 재 여기 되어 발광할 수 있도록 돋는 역할을 한다. 또한, 제2정공수송층(121c)은 발광층(121d)에 걸리는 차지(charge)를 분포시키는 역할을 한다. 따라서, 도핑층(dp)을 포함하는 제2정공수송층(121c)의 경우 위와 같은 역할을 하도록 발광층(121d)의 발광 특성을 고려하여 특정 색을 발광하는 유기 발광층 또는 각각의 색을 발광하는 유기 발광층에 포함될 수 있다. 한편, 제2정공수송층(121c)은 전자들의 여기는 돋되, 다른 층들과의 밸런스를 유지하도록 제1정공수송층(121b)의 두께보다 얇게 형성된다. 그리고 실시예에서 제2정공수송층(121c)의 두께와 정공주입층(121a)의 두께를 동일하게 형성하였으나 이에 한정되지 않는다.
- [0051] 하기 표 1은 종래 구조와 실시예의 구조에서 측정된 전압(V), 광도(cd/A), 전류(Im/W) 및 색좌표(CIE\_x, XIE\_y)를 나타낸다.

표 1

구조	실험 조건 (10mA / Cm <sup>2</sup> )에서의 광학 특성				
	V	cd/A	Im/W	CIE_x	CIE_y
종래 구조	3.0	4.5	5.0	0.147	0.060
실시예의 구조	2.9	5.1	5.3	0.147	0.063

- [0053] 상기 표 1, 도 8 및 도 9를 참조하면, 본 발명의 제1실시예에 따른 유기 발광다이오드로 구현된 소자는 강도(Intensity) 대비 파장(Wavelength)분포 그래프 상에서 실시예(Emb)와 종래 구조(Ref)가 유사한 곡선을 나타내므로 이들 간의 파장의 차이는 미묘하다. 하지만, 강도(Intensity) 대비 발광시간(Time) 분포 그래프를 참조하면 실시예(Emb)로 구현된 소자의 수명은 종래 구조(Ref)의 수명보다 상당 시간 연장되었음을 알 수 있다.

#### 제2실시예

- [0055] 도 10은 본 발명의 제2실시예에 따른 유기 발광층의 구조도 이고, 도 11은 본 발명의 제2실시예에 따른 유기 발광다이오드의 계층도 이다.
- [0056] 제2실시예의 경우 앞서 설명한 제1실시예와의 중복을 피하기 위해 구분되는 특징만 설명한다.
- [0057] 도 10 및 도 11을 참조하면, 본 발명의 제2실시예에 따른 유기 발광층은 앞서 제1실시예와 달리, 정공주입층(121a), 정공수송층(121b), 발광층(121c), 전자수송층(121d) 및 전자주입층(121e)을 포함한다. 제1실시예는 두 개의 정공수송층을 사용했지만, 제2실시예는 하나의 정공수송층(121b)을 사용하고 발광층(121c)에 포함된 도편트와 동일한 도편트가 도핑된 도핑층(dp)이 포함되어, 정공수송층(121b)의 두께를 두껍게 형성한 것이다. 즉, 제2실시예에서 정공수송층(121b)의 두께는 제1실시예에 사용된 제1정공수송층과 제2정공수송층의 두께와 같은 비율로 형성하고, 발광층(121c)과 인접한 계면에 도핑층(dp)을 형성한 것이다.
- [0058] 제2실시예와 같은 조건으로 유기 발광층(121) 내에 정공수송층(121b)을 형성한 경우도 상기 표 1, 도 8 및 도 9

와 같이 실시예(Emb)의 수명은 종래 구조(Ref)의 수명보다 상당 시간 연장될 수 있다.

[0059] 이상 본 발명은 발광층에서 여기에 참여하지 못한 전자들을 돋고 발광층의 차지를 분산시킬 수 있는 정공수송층을 마련하여 소자의 발광 효율을 개선함과 아울러 소자의 수명을 향상시킬 수 있는 유기전계발광표시장치를 제공하는 효과가 있다.

[0060] 이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하였지만, 상술한 본 발명의 기술적 구성은 본 발명이 속하는 기술 분야의 당업자가 본 발명의 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해되어야 한다. 아울러, 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어진다. 또한, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

### 도면의 간단한 설명

[0061] 도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 개략적인 블록도.

[0062] 도 2는 도 1에 도시된 서브 픽셀의 회로구성 예시도.

[0063] 도 3은 유기전계발광표시장치의 평면도.

[0064] 도 4는 도 3에 도시된 I-II 영역의 단면도.

[0065] 도 5는 서브 픽셀의 단면도.

[0066] 도 6은 본 발명의 제1실시예에 따른 유기 발광층의 구조도.

[0067] 도 7은 제1실시예에 따른 유기 발광다이오드의 계층도.

[0068] 도 8은 종래 구조와 실시예 간의 강도 대비 파장분포 그래프.

[0069] 도 9는 종래 구조와 실시예 간의 강도 대비 발광시간 분포 그래프.

[0070] 도 10은 본 발명의 제2실시예에 따른 유기 발광층의 구조도.

[0071] 도 11은 본 발명의 제2실시예에 따른 유기 발광다이오드의 계층도.

[0072] <도면의 주요 부분에 관한 부호의 설명>

[0073] 110: 기판 112: 게이트

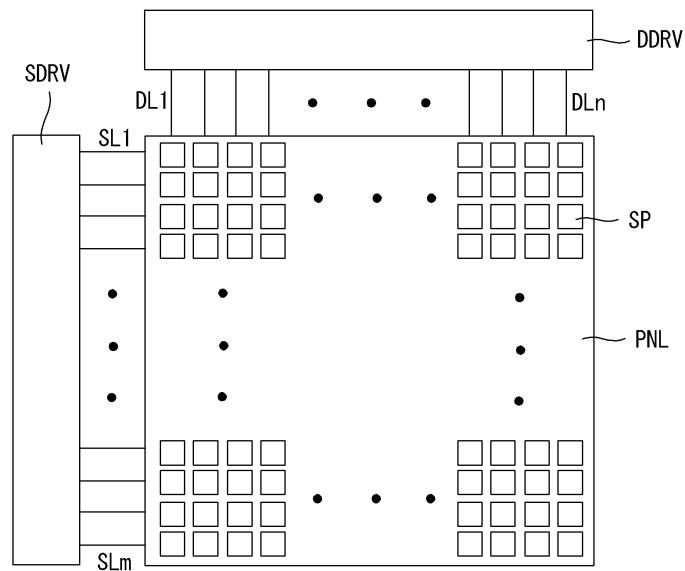
[0074] 119: 하부전극 121: 유기 발광층

[0075] 122: 상부전극 170: 접착부재

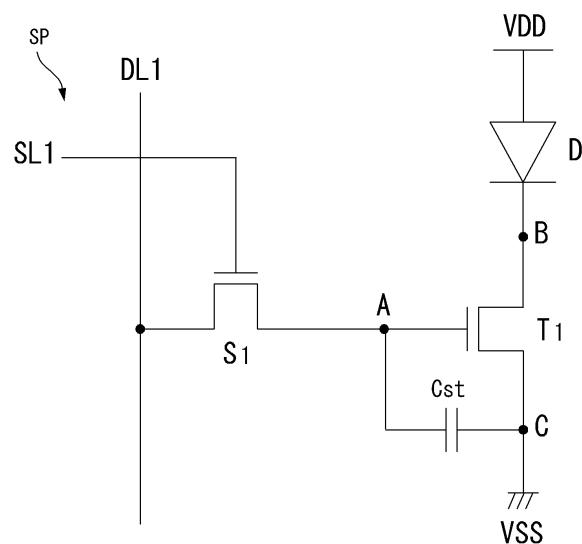
[0076] 180: 밀봉기판 SP: 서브 픽셀

도면

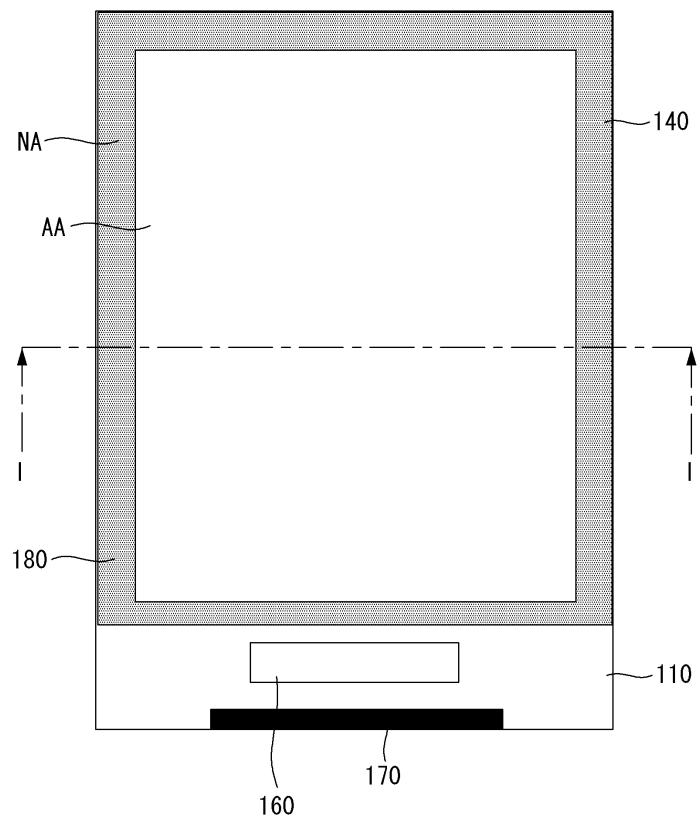
도면1



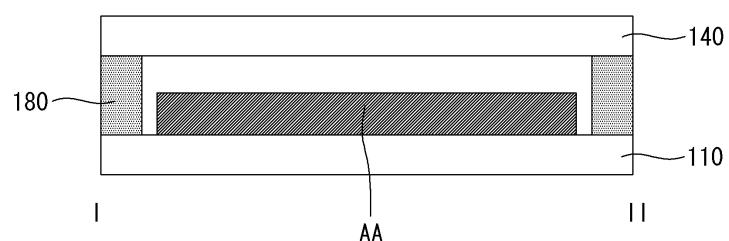
도면2



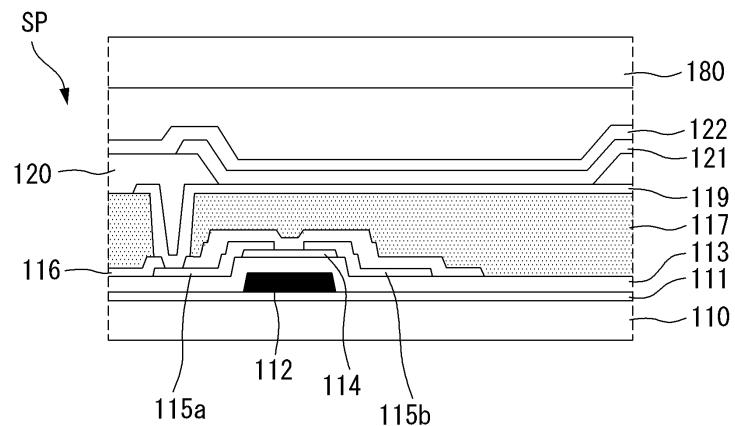
도면3



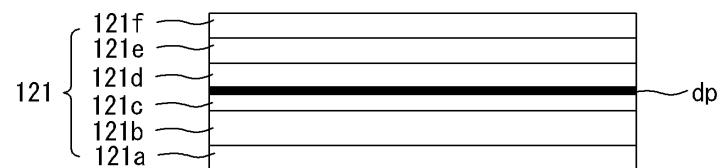
도면4



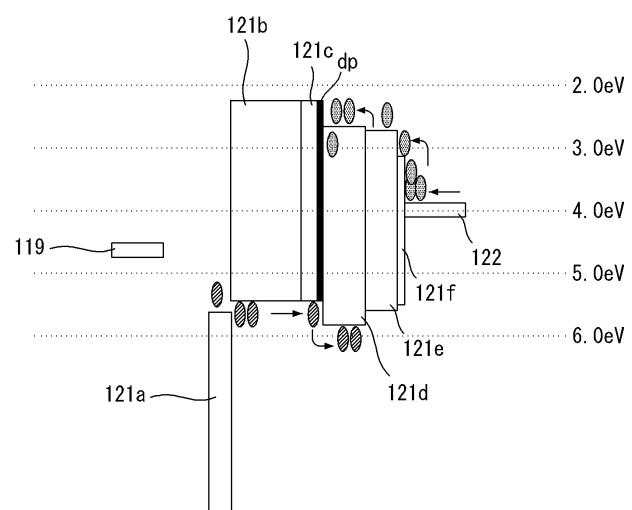
도면5



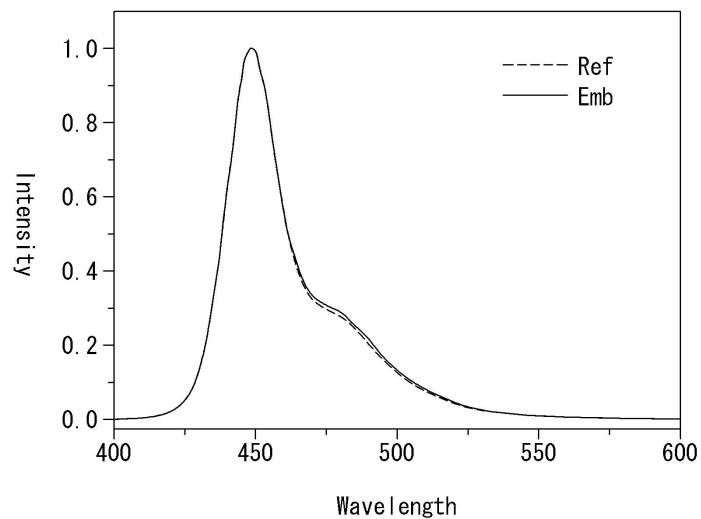
도면6



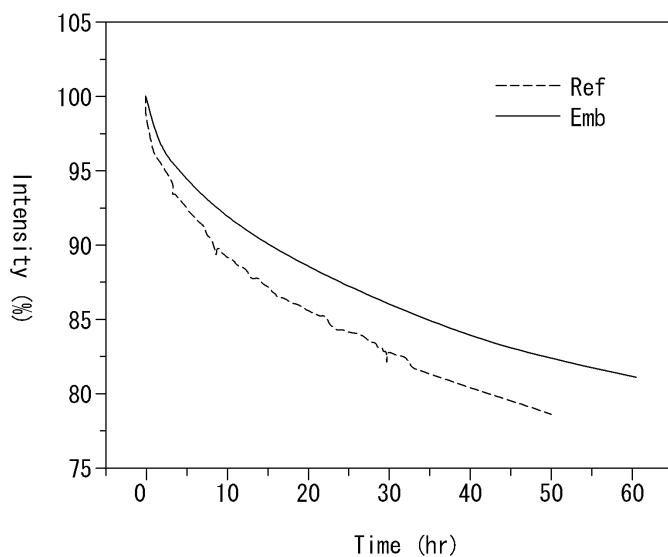
도면7



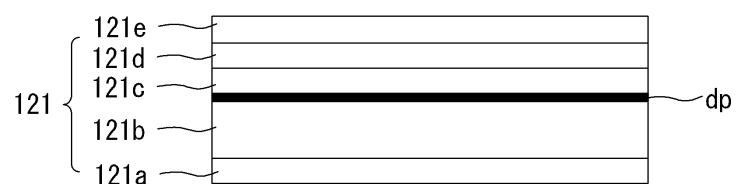
도면8



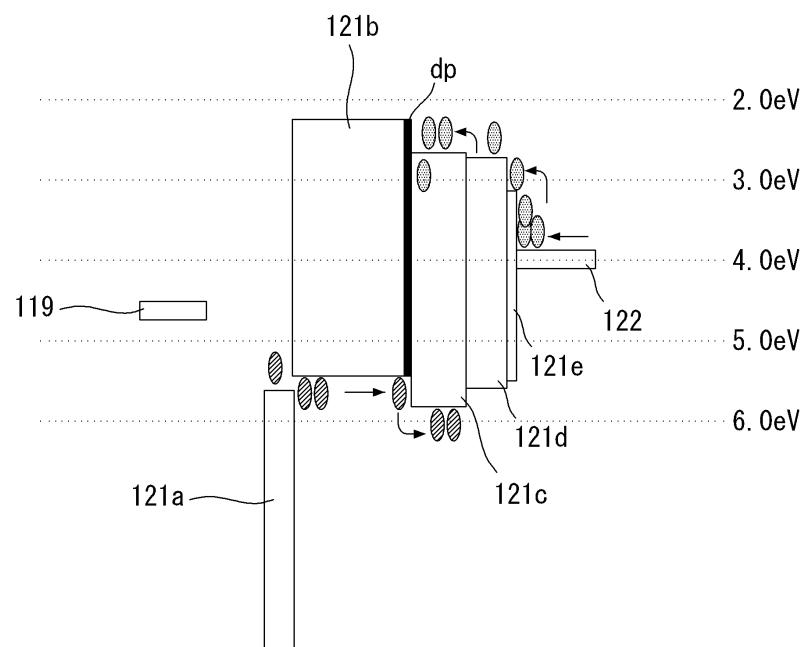
도면9



도면10



## 도면11



专利名称(译)	有机电致发光显示装置		
公开(公告)号	<a href="#">KR1020110011079A</a>	公开(公告)日	2011-02-08
申请号	KR1020090068544	申请日	2009-07-27
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	HEO JEONG HAENG 허정행 KIM KWAN SOO 김관수 JOUNG SEUNG RYONG 정승룡		
发明人	허정행 김관수 정승룡		
IPC分类号	H01L51/54 H05B33/18		
CPC分类号	H01L51/506 H01L51/5064 H01L2251/558		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

## 摘要(译)

本发明提供一种半导体器件，包括：衬底；位于基板上的下电极；有机发光层设置在下电极上；并且，上电极位于有机发光层上，其中有机发光层包括空穴传输层，该空穴传输层包含与包含在发光层中的掺杂剂相同的掺杂剂。

